

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公開番号】特開2020-63186(P2020-63186A)

【公開日】令和2年4月23日(2020.4.23)

【年通号数】公開・登録公報2020-016

【出願番号】特願2019-161167(P2019-161167)

【国際特許分類】

C 3 0 B	29/36	(2006.01)
C 3 0 B	25/20	(2006.01)
H 0 1 L	21/205	(2006.01)
H 0 1 L	21/66	(2006.01)
C 2 3 C	16/32	(2006.01)
G 0 1 N	21/956	(2006.01)
G 0 1 N	21/88	(2006.01)

【F I】

C 3 0 B	29/36	A
C 3 0 B	25/20	
H 0 1 L	21/205	
H 0 1 L	21/66	N
C 2 3 C	16/32	
G 0 1 N	21/956	A
G 0 1 N	21/88	K

【手続補正書】

【提出日】令和3年10月7日(2021.10.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1面における帯状積層欠陥の占める面積が特定されているSiC基板と、前記SiC基板の前記第1面に積層されたエピタキシャル層と、を備え、前記SiC基板の前記第1面における帯状積層欠陥の占める面積が、前記SiC基板の第1面の面積の1/4以下である、SiCエピタキシャルウェハ。

【請求項2】

前記SiC基板の第1面における帯状積層欠陥の位置が特定された、請求項1に記載のSiCエピタキシャルウェハ。

【請求項3】

前記帯状積層欠陥の密度が、10個cm⁻²以下である、請求項1に記載のSiCエピタキシャルウェハ。